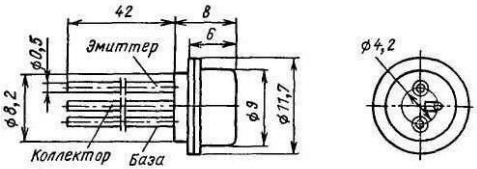


2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И, 2Т603Е, 2Т603З, 2Т603Д, 2Т603И, 2Т603Е, 2Т603З, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603Д, 2Т603Е

Предельные эксплуатационные данные

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* импульсные высокочастотные маломощные
 Предназначены для применения в импульсных и переключа-
 тельных высокочастотных схемах
 Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выво-
 дам. Обозначение типа приводится на корпусе.
 Масса транзистора не более 1,75 г.



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г не более 0,8 В
 типовое значение 0,2* В
 КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более 1,0 В
 при $I_K = 350$ мА, $I_B = 50$ мА 2Т603И не более 1,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер:
 при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более 1,5 В
 типовое значение 0,9* В
 при $I_K = 350$ мА, $I_B = 50$ мА 2Т603И не более 1,3 В
 типовое значение 1,0* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 2$ В при $T = 298$ К:
 при $I_3 = 150$ мА:
 2Т603А, 2Т603В, КТ603Д 20 – 80
 КТ603А, КТ603В 10 – 80
 2Т603Б, 2Т603Г 60 – 180
 КТ603Б, КТ603Г не менее 60
 КТ603Е 60 – 200
 при $I_3 = 350$ мА 2Т603И не менее 20
 типовое значение 50*
 при $T = 213$ К, $I_3 = 150$ мА:
 2Т603А, 2Т603В 8 – 80
 2Т603Б, 2Т603Г 20 – 180
 2Т603И не менее 8
 при $T = 398$ К, $I_3 = 150$ мА:
 2Т603А, 2Т603В 20 – 180
 2Т603Б, 2Т603Г 60 – 400
 2Т603И не менее 20

Время релаксации при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И не бо-
 лее 70 нс
 типовое значение 40* нс
 КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более 100 нс

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_3 = 30$ мА, $f = 5$ МГц не более 400 пс
 типовое значение 25* пс

Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_3 = 30$ мА, не менее 200 МГц
 типовое значение 370* МГц

Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 10$ В, $f = 5$ МГц не более 15 пФ
 типовое значение 3* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, $f = 5$ МГц не более 40 пФ
 типовое значение 35* пФ

Обратный ток коллектора, не более при $T = 298$ К при $U_{КБ} = 30$ В
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И 3 мкА
 КТ603А, КТ603Б 10 мкА
 при $U_{КБ} = 15$ В
 2Т603В, 2Т603Г 3 мкА
 КТ603В, КТ603Г 5 мкА
 при $U_{КБ} = 10$ В КТ603Д, КТ603Е 1 мкА
 при $T = 398$ К
 при $U_{КБ} = 24$ В 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И 60 мкА
 при $U_{КБ} = 12$ В 2Т603В, 2Т603Г 60 мкА

Обратный ток эмиттера не более при $U_{ЭБ} = 3$ В 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е 3 мкА
 при $U_{ЭБ} = 4$ В 2Т603И 3 мкА

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм при $T_n \leq 343$ К
 КТ603А, КТ603Б 30 В
 КТ603В, КТ603Г 15 В
 КТ603Д, КТ603Е 10 В
 при $T_n \leq 373$ К
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И 30 В
 2Т603В, 2Т603Г 15 В
 при $T_n = 393$ К
 КТ603А, КТ603Б 15 В
 КТ603В, КТ603Г 7,5 В
 КТ603Д, КТ603Е 10 В
 при $T = 398$ К:
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И 24 В
 2Т603В, 2Т603Г 12 В
 при $T = 423$ К:
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И 18 В
 2Т603В, 2Т603Г 9 В

Напряжение эмиттер-база.
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г 3 В
 2Т603И при $T_n \leq 343$ К 4 В
 2Т603И при $T_n = 398$ К 3 В

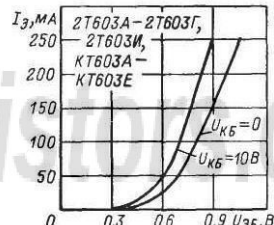
Постоянный ток коллектора 300 мА
 Импульсный ток коллектора при $t_{\text{им}} \leq 10$ мкс, $Q \geq 10$ 600 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:
 при $T < 323$ К 0,5 Вт
 при $T = 358$ К КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е и $T = 398$ К 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И 0,12 Вт

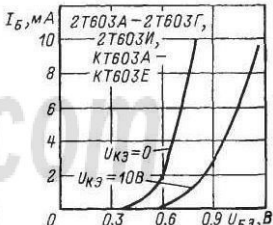
Температура перехода:
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И 423 К
 КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е 393 К

Общее тепловое сопротивление 200 К/Вт
 Температура окружающей среды:
 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И От 213 до 398 К
 КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е От 233 до 358 К

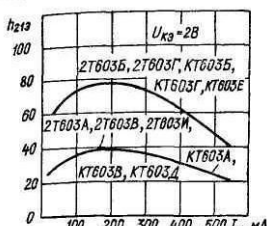
Примечание. Расстояние от корпуса до начала изгиба вы-
 вода 3 мм.
 Не допускается пайка выводов на расстоянии менее 5 мм от корпуса. Пайку выводов следует производить не более 10 с при температуре не более 543 К с теплоотводом между корпусом и местом пайки.
 Запрещается кручение выводов вокруг осн.



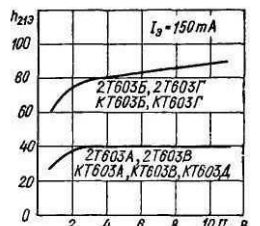
Зависимость тока эмиттера от напряжения эмиттер-база.



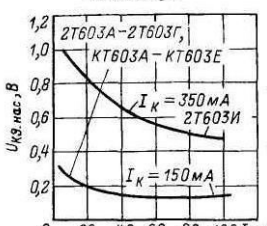
Входные характеристики.



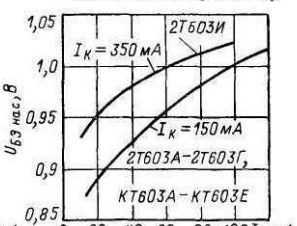
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.



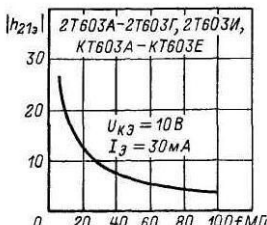
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер.



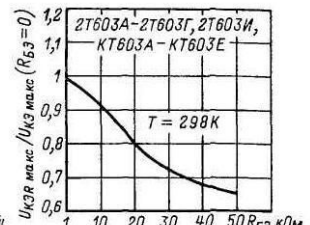
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы.



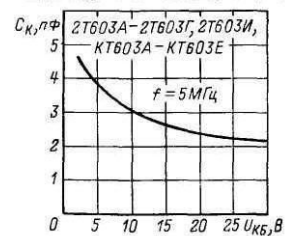
Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока базы.



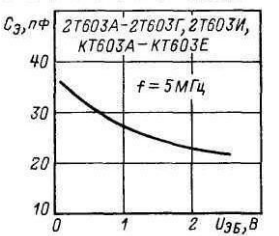
Зависимость модуля коэффициента передачи тока от частоты.



Зависимость максимального допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.



Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база.